【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成30年2月1日(2018.2.1)

【公表番号】特表2016-534962(P2016-534962A)
【公表日】平成28年11月10日(2016.11.10)
【年通号数】公開・登録公報2016-063
【出願番号】特願2016-522765(P2016-522765)
【国際特許分類】
Ｃ０３Ｃ　17/42　(2006.01)
Ｃ０３Ｃ　17/30　(2006.01)
Ｃ０３Ｃ　17/22　(2006.01)
Ｃ０３Ｃ　17/245　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ０３Ｃ　17/42
Ｃ０３Ｃ　17/30　Ｂ
Ｃ０３Ｃ　17/22　Ｚ
Ｃ０３Ｃ　17/245　Ａ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成29年11月29日(2017.11.29)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
物品において、
対向する２つの主面を有し、第１の平均破壊歪みを有するガラス基板、
第１の主面上に配置されて、第１の界面を形成する亀裂軽減層、および
前記亀裂軽減層上に配置されて、第２の界面を形成するクロム又はインジウムスズ酸化物を含む膜であって、前記第１の平均破壊歪みより小さい第２の平均破壊歪みを有する膜、
を備え、
前記第１の界面および前記第２の界面の少なくとも一方が、前記物品が前記第１の平均破壊歪みと前記第２の平均破壊歪みとの間の歪みレベルまで歪まされたときに、前記亀裂軽減層の少なくとも一部が、凝集破壊、該第１の界面での接着破壊および該第２の界面での接着破壊の１つ以上を経験するように、中程度の付着力を示し、
前記亀裂軽減層が、２００オングストローム～２０００オングストロームの厚さを有する個別の金属フッ化物膜を含む、
物品。
【請求項２】
前記亀裂軽減層が、５００オングストローム～１０００オングストロームの厚さを有する、請求項１記載の物品。
【請求項３】
前記金属フッ化物膜が、真空蒸着技法により得られたものである、請求項１記載の物品。
【請求項４】
前記ガラス基板が、化学強化されており、約５００ＭＰａ超の圧縮応力および約１５μ

ｍ超の圧縮層の深さを有する、請求項１記載の物品。
【請求項５】
前記亀裂軽減層が、フッ化バリウム、フッ化カルシウムまたはフッ化マグネシウムを含む、請求項１記載の物品。
【請求項６】
物品において、
対向する２つの主面を有し、第１の平均破壊歪みを有するガラス基板、
第１の主面上に配置されて、第１の界面を形成する亀裂軽減層、および
前記亀裂軽減層上に配置されて、第２の界面を形成するクロム又はインジウムスズ酸化物を含む膜であって、前記第１の平均破壊歪みより小さい第２の平均破壊歪みを有する膜、
を備え、
前記物品が、前記第１の界面および前記第２の界面の１つ以上で、約４Ｊ／ｍ^{2}未満の有効付着エネルギーを示し、
前記亀裂軽減層が、２００オングストローム～２０００オングストロームの厚さを有する個別の金属フッ化物膜を含む、
物品。
【請求項７】
前記有効付着エネルギーが約０．８５Ｊ／ｍ^{2}未満である、請求項６記載の物品。
【請求項８】
前記金属フッ化物膜が、真空蒸着技法により得られたものである、請求項６記載の物品。
【請求項９】
前記ガラス基板が、強化されており、約５００ＭＰａ超の圧縮応力および約１５μｍ超の圧縮層の深さを有する、請求項６記載の物品。
【請求項１０】
前記亀裂軽減層が、フッ化バリウム、フッ化カルシウムまたはフッ化マグネシウムを含む、請求項６記載の物品。
【請求項１１】
物品において、
対向する２つの主面を有し、第１の平均破壊歪みを有するガラス基板、
第１の主面上に配置される亀裂軽減層、および
前記亀裂軽減層上に配置される、クロム又はインジウムスズ酸化物を含む膜であって、前記第１の平均破壊歪みより小さい第２の平均破壊歪みを有する膜、
を備え、
前記亀裂軽減層が、前記膜および前記ガラス基板の一方から始まり、該亀裂軽減層に入って、該亀裂軽減層内に実質的に留まる亀裂を生じるものであり、
前記亀裂軽減層が、２００オングストローム～２０００オングストロームの厚さを有する個別の金属フッ化物膜を含む、
物品。
【請求項１２】
前記亀裂軽減層が、フッ化バリウム、フッ化カルシウムまたはフッ化マグネシウムを含む、請求項１１記載の物品。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１２０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１２０】
ある場合には、亀裂軽減層１３０は無機材料を含む。その無機材料としては、金属フッ

化物（例えば、CAF_2、BAF_2、ALF_3、MGF_2、SRF_2、LAF_3およびランタニド系列の三フッ化物）が挙げられる。いくつかの実施の形態において、亀裂軽減層１３０は２種類以上の金属フッ化物を含む。亀裂軽減層１３０に用いられる金属フッ化物は、以下に限られないが、様々な真空蒸着技法、例えば、電子ビーム蒸着を含む様々な方法によって、ガラス基板１２０上に個々の膜として堆積させることができる。亀裂軽減層１３０に使用される個々の金属フッ化物膜、および他の無機材料は、そのような真空蒸着技法を使用して、後に続く膜１１０の堆積と共に、個々の膜としてその場で堆積させることができることが都合よい。そのような多数膜堆積手順の最中に、清浄度を維持することができる。さらに、ただ１つの真空槽内でガラス基板１２０上に多数の膜を堆積させることによって、製造時間を減少させることができる。